

## ОБРАТИМЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В СПЛАВАХ Ni–Mn–Ga В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

И.Е.Дикштейн\*, Д.И.Ермаков\*, В.В.Коледов\*+, Л.В.Коледов\*, Т.Такаги<sup>□</sup>,  
А.А.Тулайкова\*, А.А.Черечукин\*+, В.Г.Шавров\*<sup>1)</sup>

\* Институт радиотехники и электроники РАН  
103907 Москва, Россия

+Лаборатория сильных магнитных полей и низких температур  
Вроцлав, Польша

□ Университет Тохоку, Сендай, Япония

Поступила в редакцию 18 августа 2000 г.

В ферромагнитных сплавах с памятью формы  $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$  со сливающимися магнитным и структурным фазовыми переходами в полях порядка 10 Тл наблюдался обратимый структурный фазовый переход по полю при постоянной температуре и давлении. Результаты расчета находятся в качественном согласии с экспериментом.

PACS: 64.70.Kb

Сплав Гейслера  $Ni_2MnGa$ , сочетающий свойства ферромагнетизма и памяти формы, вызывает большой интерес в связи с поиском новых эффектов влияния внешних полей на размеры и форму вещества [1 – 6]. В недавних исследованиях показано теоретически и экспериментально, что фазовая диаграмма нестехиометрических составов  $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$  с частичным замещением Mn на Ni, включает область концентраций  $x$ , в которой магнитный и структурный (мартенситный) фазовые переходы (ФП) близки или сливаются ( $x = 0.16 – 0.19$ ). В таких сплавах обнаружено значительное увеличение температуры структурного ФП (СФП) под действием магнитного поля (до 1 Тл) и эффект инициирования СФП при включении магнитного поля [5]. Однако до сих пор оставался не решенным вопрос: возможен ли управляемый магнитным полем обратимый СФП при постоянных температуре и давлении? Цель настоящей работы – экспериментальное и теоретическое исследование обратимого СФП по магнитному полю в образцах со сливающимися структурным и магнитным ФП.

Осуществлению обратимого СФП по магнитному полю при определенной температуре препятствует температурный гистерезис СФП 1-го рода. Идея эксперимента заключается в следующем. Под действием внешнего магнитного поля оба края температурной петли гистерезиса (ее ширина порядка нескольких градусов) смешаются в сторону увеличения температуры СФП с коэффициентом порядка 1 К/Тл [5]. Значит, в поле порядка 10 Тл вся петля сместится по оси температур на расстояние больше своей ширины. В этом случае переход из высокотемпературной фазы (аустенит) в низкотемпературную фазу (мартенсит) в поле будет происходить при более высокой температуре  $T_{AM}(H)$ , чем обратный переход без поля – при  $T_{MA}(0)$ . Включение и выключение поля при определенной температуре из интервала  $T_{MA}(0) < T < T_{AM}(H)$  должно вызывать обратимый СФП. Область температур

<sup>1)</sup> e-mail: shavrov@mail.cplire.ru

$\Delta\bar{T} = T_{AM}(H) - T_{MA}(0)$  назовем интервалом магнитного управления структурным ФП.

Для эксперимента поликристаллические образцы  $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$  изготавливались методом дуговой плавки в атмосфере аргона на холодном поду. Фазовое структурное состояние образцов исследовалось в магнитном поле 0–14 Тл оптическим методом [5]. Оптическая методика позволяет в прямом эксперименте наблюдать зарождение и движение границ СФП, а также двойниковых границ структурных доменов, и по этим наблюдениям проводить измерение температур прямого и обратного СФП с разрешением по поверхности образца в зависимости от внешнего магнитного поля. Для исследования СФП образец полируют в austenитном состоянии и укрепляют на подложке в прозрачном двухконтурном термостате в поле биттеровского магнита. Наблюдения проводят при помощи микроскопа с телевизионной камерой в отдельных микрокристаллах поликристалла. Это позволяет учесть естественную неоднородность поликристаллических образцов, с которой связана основная погрешность определения точки перехода.

Зависимости  $T_{AM}(H)$  и  $T_{MA}(H)$  представлены для образцов с избыточной концентрацией Ni ( $x = 0.16, 0.18, 0.19$ ) на рис.1. При построении графиков температура перехода усреднялась по поверхности поликристаллического образца. Видно, что во всех образцах зависимость  $T_{AM}(H)$  и  $T_{MA}(H)$  приближенно линейная. Коэффициенты  $dT_{AM}/dH$  и  $dT_{MA}/dH$  близки по значению и возрастают с увеличением  $x$  вплоть до значения  $x = 0.19$ , при котором магнитный и структурный ФП сливаются [5]. При увеличении  $x$  заметно возрастает и температурный гистерезис СФП  $T_{MA}(H) - T_{AM}(H)$ . Интервал магнитного управления в среднем по площади образца  $\Delta\bar{T} \sim 1$  К.

Опыт по обратимому СФП, индуцированному магнитным полем, при постоянных температуре и внешнем давлении иллюстрирует рис.2. На нем представлены графики зависимости от времени магнитного поля, температуры образца и количества микрокристаллитов поликристаллического образца  $N$ , изменивших фазовое структурное состояние в ходе эксперимента. Исходная температура образца была выбрана внутри интервала магнитного управления СФП, а все микрокристаллиты в поле зрения микроскопа находились в austenитном состоянии. При увеличении магнитного поля начинается спонтанное увеличение температуры образца с образованием мартенсита при  $H > 6$  Тл. Когда возрастание поля прекращается, температура релаксирует, а доля мартенсита еще некоторое время растет. При снижении магнитного поля температура снижается, а начиная от 4 Тл мартенсит исчезает. Полное его исчезновение заканчивается после выключения поля в процессе возвращения температуры образца к исходному значению.

Нестабильность температуры образца объясняется выделением и поглощением в нем скрытой теплоты СФП 1-го рода. Каждый раз увеличение температуры происходит одновременно с переходом в низкотемпературную фазу, а уменьшение при переходе в высокотемпературную фазу.

Для анализа фазовой диаграммы ферромагнетика  $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$  в магнитном поле будем использовать феноменологическую модель ФП Ландау. Рассмотрим кубический ферромагнетик точечной группы симметрии  $O_h$  с магнитным ФП, сопровождающимся появлением спонтанной намагниченности  $M$ , и с собственным ферроэластическим ФП в тетрагональную фазу симметрии  $D_{4h}$ , при котором возникают

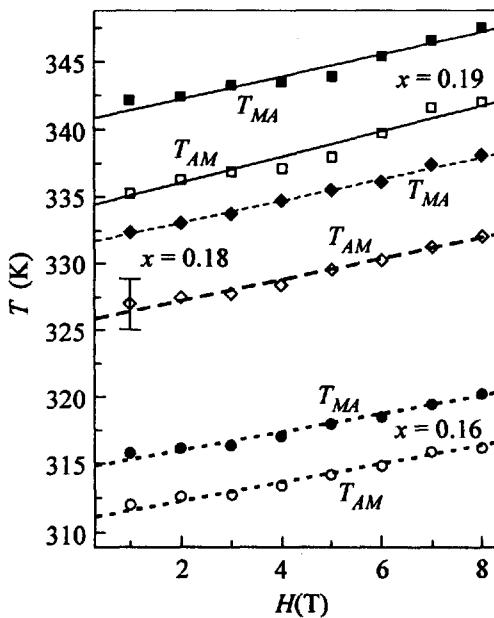


Рис.1. Полевые зависимости температур прямого  $T_{AM}$  и обратного  $T_{MA}$  структурного фазового перехода образцов  $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$  для  $x = 0.16, 0.18, 0.19$

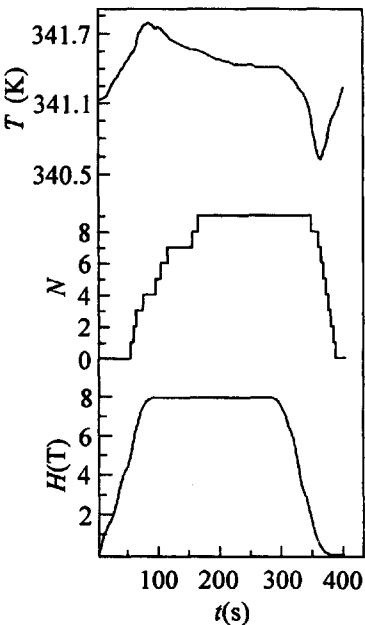


Рис.2. Временные зависимости температуры  $T$ , поля  $H$  и количества микрокристаллитов поликристаллического образца  $N$ , испытавших структурное превращение, в процессе обратимого СФП

спонтанные деформации. В этом случае параметрами порядка, описывающими СФП, являются компоненты макроскопического тензора деформаций  $e_{ik}$ . Магнитные ФП будем описывать компонентами макроскопической намагниченности  $M$ . Выражение для свободной энергии ферромагнетика после ее минимизации по компонентам тензора деформаций, не ответственных за СФП, принимает вид

$$F = F_0 + \frac{1}{2}a(e_2^2 + e_3^2) + \frac{1}{3}be_3(e_3^2 - 3e_2^2) + \frac{1}{4}c(e_2^2 + e_3^2)^2 + \\ + B_2 \left[ \frac{1}{\sqrt{2}}e_2(m_1^2 - m_2^2) + \frac{1}{\sqrt{6}}e_3(3m_3^2 - m^2) \right] + \frac{1}{2}\alpha(m_1^2 + m_2^2 + m_3^2) + \\ + \frac{1}{4}\delta(m_1^2 + m_2^2 + m_3^2)^2 + K(m_1^2m_2^2 + m_2^2m_3^2 + m_3^2m_1^2) - H_3M_3. \quad (1)$$

Здесь  $\alpha = \alpha_0(T - T_c)$ ,  $\delta$  и  $K$  – перенормированные магнитострикцией обменные константы и первая константа кубической анизотропии;  $B$  – постоянная релятивистской магнитострикции;  $a$ ,  $b$  и  $c$  – линейные комбинации компонент модулей упругости второго, третьего и четвертого порядков, соответственно,  $a = c_{11} - c_{12}$ ,  $b = (c_{111} - c_{112} - c_{123})/6\sqrt{6}$ ;  $e_i$  – линейные комбинации компонент тензора деформаций:  $e_2 = (e_{zz} - e_{yy})/\sqrt{2}$ ,  $e_3 = (2e_{zz} - e_{xx} - e_{yy})/\sqrt{6}$ ;  $m = M/M_0$ ,  $M_0$  – намагниченность насыщения вдали от точки Кюри  $T_C$ . При подходе к точке СФП из кубической в тетрагональную фазу с двухкомпонентным параметром порядка  $e_2$ ,  $e_3$  упругий модуль

$a = c_{11} - c_{12}$  стремится к нулю и вблизи точки перехода  $T_{M0}$  его можно представить в виде  $a = a_0(T - T_{M0})$ . Наличие в термодинамическом потенциале слагаемых третьего порядка обуславливает СФП 1-го рода.

Рассмотрим случай  $b > 0$ ,  $c > 0$ ,  $K < 0$ , соответствующий данному соединению. При этом в отсутствие поля реализуются пять различных фаз [4, 5, 7]: парамагнитная и ферромагнитная кубические фазы, парамагнитная тетрагональная фаза и ферромагнитная угловая и колинеарная тетрагональные фазы. В магнитном поле точка Кюри исчезает как точка ФП, ибо при  $H \neq 0$  намагниченность остается конечной за счет парапроцесса и при  $T > T_C$ . Кроме того, данное поле приводит к тетрагональным искажениям кубической решетки. Тогда в магнитных полях, больших поля магнитной анизотропии  $H > H_A = K/M_0$ , будут осуществляться две различные ферромагнитные фазы: мартенситная фаза с большими тетрагональными искажениями и аустенитная фаза со слабыми тетрагональными искажениями, вызванными полем.

Минимизируя потенциал (1) по переменным  $e_2$ ,  $e_3$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  и  $m_3$ , находим в приближении достаточно сильных полей ( $H > H_A$ ) следующие уравнения состояния, описывающие распределения намагниченности и упругих деформаций в рассматриваемом ферромагнетике и условия их устойчивости:

$$m_1 = m_2 = 0, \quad e_2 = 0, \quad m_3 \left( \alpha + \delta m_3^2 + \sqrt{8/3}Be_3 \right) = M_0H, \quad (2)$$

$$e_3(a + be_3 + ce_3^2) + \sqrt{2/3}Bm_3^2 = 0, \quad (2\delta m_3^3 + M_0H)(a + 2be_3 + 3ce_3^2) - \frac{8}{3}B^2m_3^3 \geq 0. \quad (3)$$

При  $x < x_C$  ( $x_C$  – критическая концентрация, при которой температуры магнитного и структурного ФП сливаются) из (2), (3) находим полевые зависимости температур потери устойчивости  $T_{MA}$  и  $T_{AM}$  (см. рис.3):

$$T_{MA} = T_{M0} \left\{ 1 + \frac{b}{a_0} \left[ \frac{1}{36} \frac{b}{c} - \sqrt{6} \frac{cB}{b^2} \left( \tau_{M0} - \frac{2}{3}m^2(\tau_{MA}) \right) \right] \right\}, \quad (4)$$

$$T_{AM} = T_{M0} \left\{ 1 - \frac{b}{a_0} \left[ \frac{2}{9} \frac{b}{c} + \sqrt{6} \frac{cB}{b^2} \tau_{M0} + \left( \sqrt{\frac{32}{3}} \frac{B}{b} \right)^{1/2} m(\tau_{M0}) \right] \right\}, \quad (5)$$

где функция  $m(\tau) = [h + (h^2 - \tau^3/27)^{1/2}]^{1/3} + [h - (h^2 - \tau^3/27)^{1/2}]^{1/3}$  при  $h > (\tau/3)^{3/2}$  и  $m(\tau) = 2\sqrt{\tau/3} \cos(\varphi(\tau)/3)$  при  $h < (\tau/3)^{3/2}$ ,  $\varphi(\tau) = \text{Arccos}[h(3/\tau)^{3/2}]$ ,  $\tau_{M0} = (T_C - T_{M0})/T_C$ ,  $\tau_{MA} = \tau_{M0} + \sqrt{2/3}(bB/c\delta)$ ,  $h = MH/2\delta$ .

Полевая зависимость температуры СФП  $T_M$  (рис.3), которая определяется из условия равенства энергий фаз, имеет вид

$$T_M = T_{M0} \left\{ 1 + \frac{b}{a_0} \left[ \frac{9}{8} \frac{\delta c^2}{b^3} \{m^4(\tau_M) - m^4(\tau_{M0}) + \right. \right. \\ \left. \left. + 4h[m(\tau_M) - m(\tau_{M0})]\} - \sqrt{6} \frac{cB}{b^2} \tau_{M0} - \frac{4}{3} \frac{B^2}{\delta b} \right] \right\}, \quad (6)$$

$$\tau_M = \tau_{M0} + \sqrt{\frac{32}{27}} \frac{bB}{c\delta}.$$

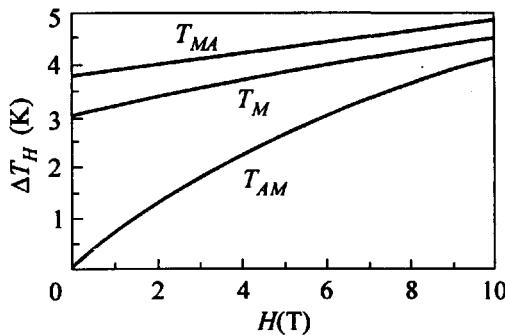


Рис.3. Сечение  $T - H - x$  фазовой диаграммы плоскостью  $x = 0.16$ :  $\Delta T_H = T_i(H) - T_{AM}(H = 0)$ , где  $T_i = T_M, T_{MA}, T_{AM}$

При  $h \ll (\tau_{M0}/3)^{3/2}$  полевые зависимости  $T_{MA}$ ,  $T_{AM}$  и  $T_M$  упрощаются. Так, например,  $T_M$  становится линейной функцией  $H$ :

$$T_M(H) = T_M(0) + HT_{M0}M(\sqrt{\tau_M} - \sqrt{\tau_{M0}})/Q, \quad (7)$$

где  $Q = 2a_0b^2/9c^2$  – удельная скрытая теплота СФП при температуре  $T_M(0)$ . Это соответствует результатам [4, 5], полученным из простой термодинамической теории.

Для построения фазовой диаграммы ферромагнетика в координатах  $T - H - x$  предположим, следуя [4, 5], линейную зависимость от концентрации величин  $T_{M0}$  и  $T_C$ :

$$T_{M0} = \tilde{T}_{M0} + \kappa x, \quad T_C = \tilde{T}_C - \gamma x, \quad (8)$$

где  $\kappa$  и  $\gamma$  – коэффициенты пропорциональности.

Сечения  $T - H - x$  фазовой диаграммы плоскостями  $x = 0.16$  и  $H = 0$  показаны на рис.3 и 4, соответственно. Мы приводим зависимости  $\Delta T_H(H)$  и  $\Delta T_x(x)$ . Здесь  $\Delta T_H = T_i(H) - T_{AM}(H = 0)$ , а  $\Delta T_x = T_i(x) - T_{AM}(x = 0.14)$ , где  $T_i = T_M, T_{MA}, T_{AM}$ . Так как многие параметры задачи в настоящее время неизвестны, то сопоставление полученных теоретических диаграмм с экспериментальными на рис.1 будет носить лишь качественный характер. Представленные на рис.3 и 4 диаграммы получены при следующих значениях параметров:  $\tilde{T}_C = 375$  К,  $\tilde{T}_{M0} = 200$  К,  $a_0 = b/\tilde{T}_{M0}$ ,  $\alpha_0 = \delta/\tilde{T}_C$ ,  $\delta = 10^8$  Эрг/см<sup>3</sup>,  $c/b = 11.1$ ,  $b = 2.54 \cdot 10^{12}$  Эрг/см<sup>3</sup>,  $B = 2 \cdot 10^8$  Эрг/см<sup>3</sup>,  $\gamma = 175$  К,  $\kappa = 700$  К.

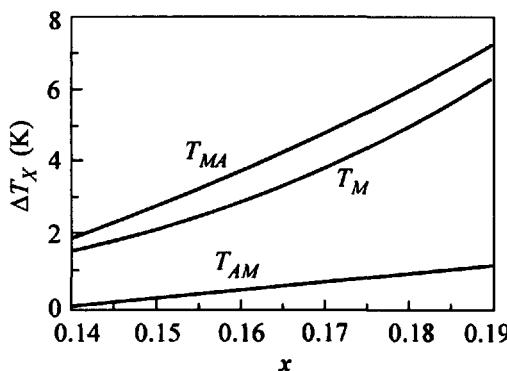


Рис.4. Сечение  $T - H - x$  фазовой диаграммы плоскостью  $H = 0$ :  $\Delta T_x = T_i(x) - T_{AM}(x = 0.14)$ , где  $T_i = T_M, T_{MA}, T_{AM}$

Из сравнения рис.1, 3 и 4 следует, что в интервале концентраций  $0.16 > x > 0.19$  полученные в эксперименте полевые и концентрационные зависимости  $T_{AM}$  и  $T_{MA}$

находятся в качественном согласии с результатами расчета. В частности, величины температур  $T_{AM}$  и  $T_{MA}$  возрастают с ростом  $H$  и  $x$ , а ширина температурной петли гистерезиса возрастает с ростом  $x$ . Теория подтверждает существование области температур и полей, в которой возможен обратимый СФП по магнитному полю.

Отметим, что необратимый СФП по магнитному полю известен во многих магнитных веществах (см., например, [8, 9]). Авторам не известны другие вещества, в которых имел бы место обратимый СФП по полю. Однако следует ожидать, что обнаруженный в данной работе в соединении  $Ni_{2+x}Mn_{1-x}Ga$  управляемый магнитным полем обратимый СФП, по-видимому, может наблюдаться в достаточно сильных полях и в других магнитных соединениях с большой магнитострикцией, в которых имеет место структурное фазовое превращение в ферромагнитном состоянии.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (грант # 99-02-18247).

- 
1. K.Ullakko, J.K.Huang, C.Kantner et al., *Appl. Phys. Lett.* **69**, 1966 (1996).
  2. R.C.O'Handley, *J. Appl. Phys.* **83**, 1263 (1998).
  3. R.D.James and M.Wutting, *Philos. Mag. A* **77**, 1273 (1998).
  4. A.N.Vasil'ev, A.D.Bozhko, V.V.Khovailo et al., *Phys. Rev. B* **59**, 1113 (1999).
  5. А.Д.Божко, А.Н.Васильев, В.В.Ховайло и др., *ЖЭТФ* **115**, 1740 (1999).
  6. G.H.Wu, C.H.Yu, L.Q.Meng et al., *Appl. Phys. Lett.* **75**, 2990 (1999).
  7. А.Д.Божко, В.Д.Бучельников, А.Н.Васильев и др., *Письма в ЖЭТФ* **67**, 212 (1998).
  8. М.А.Кривоглаз, В.Д.Садовский, *ФММ* **18**, 502 (1964).
  9. Д.А.Мирзаев, В.М.Счастливцев, *ФММ* **63**, 1105 (1987).